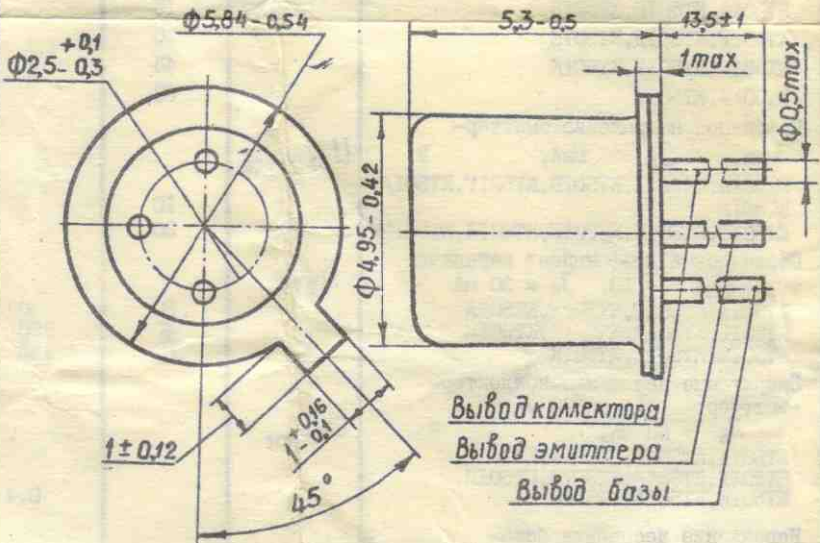




ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов: КТ501А, КТ501Б,
КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е,
КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М
соответствуют ГОСТ 11630 - 84 и
техническим условиям АА0.336.064 ТУ



26.08.82

Масса транзистора не более 0,6 г
Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.
транзисторов :

золото 94,97 192 мг

Л.Н.

**Основные электрические параметры при нормальных
климатических условиях**

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения, тип транзистора	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$, $I_K = 1 \text{ мкА}$, В	$U_{КЭRпроб}$		
КТ501А, КТ501Б, КТ501В		15	
КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е		30	
КТ501Ж, КТ501И, КТ501К		45	
КТ501Л, КТ501М		60	
Пробивное напряжение эмиттер-база, $I_Б = 1 \text{ мкА}$, В	$U_{ЭБ0проб}$		
КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е		10	
КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М		20	
Статический коэффициент передачи тока, $U_{КЭ} = -1В$, $I_K = 30 \text{ мА}$	$h_{21э}$		
КТ501А, КТ501Г, КТ501Ж, КТ501Л		20	60
КТ501Б, КТ501Д, КТ501И, КТ501М		40	120
КТ501В, КТ501Е, КТ501К		80	240
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер $I_K = 300 \text{ мА}$, $I_Б = 60 \text{ мА}$, В	$U_{КЭнас}$		
КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е, КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М			0,4
Напряжение насыщения база-эмиттер, $I_K = 300 \text{ мА}$, $I_Б = 60 \text{ мА}$, В	$U_{БЭнас}$		
КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е, КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М			1,5

Место штампа ОТК



Место штампа
Государственной приёмки